

**Особенности**

- коммутируемое напряжение  $\pm 60$  В
- коммутируемый ток:  
схема включения А:  $\pm 500$ мА;  
схема включения Б: 1,0А
- ток управления 5...25 мА
- 1500В напряжение изоляции
- 8-выводной металлокерамический DIP корпус 2101.8-7

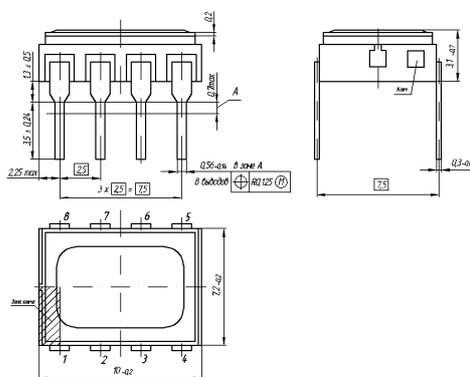
**Применение**

- замена электромагнитных реле
- телекоммуникационная техника
- аналоговые мультиплексоры

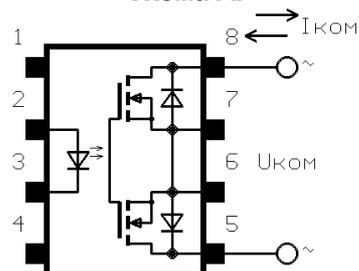
**Аналоги**

ASSR-1511 (Avago)  
HSSR-7111 (Avago)

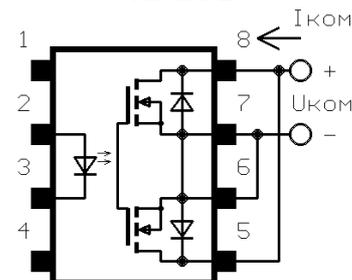
**Габаритный чертеж корпуса и назначение выводов**



**Схемы включения  
Схема А:**



**Схема Б:**



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°С)**

Наименование параметра	Обозн.	Ед. изм.	Значение			Режим измерения
			мин	тип	макс	
Входное напряжение	$U_{вх}$	В	1,0	1,4	1,6	$I_{вх}=5\text{мА}$
Вых. сопротивление в отк. сост.	Схема включения А	$R_{отк}$				$I_{вх}=5\text{мА}$ $I_{вых}=500\text{мА}$
	Схема включения Б					0,5
Ток утечки на вых. в закрытом сост.	$I_{ут}$	мкА		0,1	1,0	$U_{вх}=0,8\text{В}$ , $U_{вых}=60\text{В}$
Напряжение изоляции	$U_{из}$	В	1500			$t=1\text{мин}$
Сопротивление изоляции	$R_{из}$	Ом	$10^9$			$U_{из}=500\text{В}$
Вых. емкость в выкл. состоянии	$C_{пр}$	пФ		30		$U_{вых}=60\text{В}$
Время включения	$T_{вкл}$	мс		2,5	5,0	$I_{вх}=5\text{мА}$ , $U_{вых}=24\text{В}$ , $R_{н}=200\text{Ом}$
Время выключения	$T_{вык.}$	мс		0,05	2,0	$I_{вх}=5\text{мА}$ , $U_{вых}=24\text{В}$ , $R_{н}=200\text{Ом}$

**ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры режима		Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	Схема включения А	В	-60	60	
	Схема включения Б	В	0	60	
Ток коммутации	Схема включения А	мА	-500	500	
	Схема включения Б	А		1,0	
Вх. ток во включенном состоянии		мА	5	25	
Вх. импульсный ток		мА		150	$T_{имп}=200\text{мкс}$
Вых. импульсный ток		А		1,5	$T_{имп}=10\text{мс}$
Вх. напряжение в выключенном состоянии		В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур		°С	-60	125	

**Параметры стойкости**

7.И <sub>1</sub>	7.И <sub>6</sub>	7.И <sub>7</sub>	7.С <sub>1</sub>	7.С <sub>4</sub>	7.К <sub>1</sub>	7.К <sub>4</sub>
0,4*1Ус	2,9*2Ус	2,88*2Ус	0,5*1Ус	0,2*1Ус	0,25*1Ус	0,28*1Ус

Наработка до отказа  $T_H$  в пределах срока службы  $T_{сл}=25\text{лет}$  при температуре не более  $(65+5)^\circ\text{C}$  - не менее 100 000 ч, и не менее 120 000 ч. в облегченном режиме ( $I_{вх} \leq 10\text{ мА}$ ,  $I_{ком} \leq 200\text{ мА}$ ,  $25^\circ\text{C}$ ).

Гамма-процентный срок сохраняемости  $T_{с\gamma}$  при  $\gamma = 99\%$  при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.